## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-226784

(43)Date of publication of application: 17.08.1992

(51)Int.Cl.

B41M 5/26

G11B 7/00 G11B 7/24

(71)Applicant: HITACHI MAXELL LTD

(22)Date of filing:

(21)Application number : 02-419029

29.12.1990

(72)Inventor: TAMURA REIJI

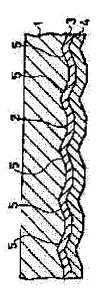
OTA NORIO

# (54) OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM AND INFORMATION RECORDING PROPUCTION METHOD

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an optical information recording medium having good recording characteristics, a capability of reproducing information by a CD player, and superior resistance to environment by selecting a recording material.

CONSTITUTION: A recording layer is made of an alloy mainly composed of at least one element selected out of an element group (Ge, Si, Sn) and at least one element selected out of an element group (Au, Ag, Al, Cu).



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

### (11)特許出願公開番号

## 特開平4-226784

(43)公開日 平成4年(1992)8月17日

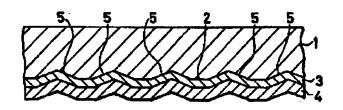
(51) Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示簡	畜所
B 4 1 M	5/26							
G11B	7/00	N	9195-5D					
	7/24	Α	7215-5D					
		В	7215-5D	,				
			8305 - 2H	B 4 1 M	5/ 26		X	
				§	審査請求	未請求	請求項の数6(全 9	頁)
(21)出願番号		特願平2-419029		(71)出願人	0000058	10		
					日立マグ	フセル株式	式会社	
(22)出願日 平		平成2年(1990)12月	平成2年(1990)12月29日		大阪府郊	大木市丑3	貫1丁目1番88号	
				(72)発明者	田村	L=		
					大阪府	英木市丑?	度1丁目1番88号 日立	エマ
					クセルも	朱式会社的	ᅒ	
				(72)発明者	太田	<b>氨雄</b>		
					大阪府	发木市丑1	寅1丁目1番88号 日立	エマ
					クセル	朱式会社	芍	
				(74)代理人	弁理士	武 顕	<b>欠郎</b>	

#### (54) 【発明の名称】 光情報記録媒体および情報の記録再生方法

### (57)【要約】

【目的】 記録材料を選択することによって、記録特性 が良好で、CDプレーヤで情報の再生ができ、かつ耐環 境性に優れた光情報記録媒体を得る。

【構成】 〔Ge, Si, Sn〕元素群から選択された 少なくとも1種類の元素と、〔Au, Ag, Al, C u) 元素群から選択された少なくとも1種類の元素とを 主成分とする合金から記録層を形成した。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板の信号面に、少なくとも記録層を含む薄膜を担持してなる光情報記録媒体において、上記基板の信号面に、直接または上記基板よりも耐熱性の低い物質からなる熱変形層を介して、〔Ge、Si、Sn〕元素群から選択された少なくとも1種類の元素と、〔Au、Ag、Al、Cu〕元素群から選択された少なくとも1種類の元素とを主成分とする合金からなる記録層を形成したことを特徴とする光情報記録媒体。

【請求項2】 基板の信号面に、少なくとも記録層を含 10 む薄膜を担持してなる光情報記録媒体において、上記基板の信号面に、直接または上記基板よりも耐熱性の低い物質からなる熱変形層を介して、〔Ge, Si, Sn〕元素群から選択された少なくとも1種類の元素を主成分とする薄膜と、〔Au, Ag, Al, Cu〕元素群から選択された少なくとも1種類の元素を主成分とする薄膜とによって構成される2層以上の積層体からなる記録層を形成したことを特徴とする光情報記録媒体。

【請求項3】 請求項1または2記載において、上記基板側から見て上記記録層の背面側に、当該記録層よりも 20 再生用光に対する反射率が高い反射層を積層したことを特徴とする光情報記録媒体。

【請求項4】 請求項1または2記載において、上記基 板側から見て上記記録層の背面側に、無機材料からなる 中間層と、上記記録層よりも再生用光に対する反射率が 高い反射層とを順次積層したことを特徴とする光情報記 録媒体。

【請求項5】 基板の信号面に、直接または上記基板よりも耐熱性の低い物質からなる熱変形層を介して、[Ge, Si, Sn]元素群から選択された少なくとも1種類の元素と、[Au, Ag, Al, Cu]元素群から選択された少なくとも1種類の元素とを主成分とする合金からなる記録層が形成された光情報記録媒体に記録用放射線ビームを照射し、その熱によって上記記録層の記録用放射線ビーム照射部の原子配列を変化させ、かつ該部下地の基板または熱変形層を変形させて情報の記録を行い、また、上記原子配列の変化および上記基板または熱変形層の変形に伴う反射率の変化を光学的に読み出すことによって情報の再生を行うことを特徴とする情報の記録再生方法。

【請求項6】 基板の信号面に、直接または上記基板よりも耐熱性の低い物質からなる熱変形層を介して、[Ge,Si,Sn]元素群から選択された少なくとも1種類の元素を主成分とする薄膜と、[Au,Ag,A1,Cu]元素群から選択された少なくとも1種類の元素を主成分とする薄膜との2層以上の積層体からなる記録層が形成された光情報記録媒体に記録用放射線ビームを照射し、その熱によって上記記録層の記録用放射線ビーム照射部を溶融して混合させ、かつ該部下地の基板又は熱変形層を変形させて情報の記録を行い、また。上記記録

Z

層の混合部および上記基板または熱変形層の変形に伴う 反射率の変化を光学的に読み出すことによって情報の再 生を行うことを特徴とする情報の記録再生方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、レーザ光や電子線等の放射線エネルギによって、例えば映像や音声などのアナログ信号をFM変調したものや、電子計算機のデータ、それにファクシミリ信号やディジタルオーディオ信号などのディジタル情報を、リアルタイムで記録することが可能な光情報記録媒体、およびそれを用いた情報の記録再生方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来より、基板上にヒートモード記録材料よりなる薄膜(記録層)を担持し、放射線の光熱作用によって情報の追記を可能にした光情報記録媒体が知られている。

【0003】放射線によって薄膜に記録を行う記録原理は種々あり、Te、Biなどを主成分とした金属層やシアニンなどの色素層からなる記録薄膜の変形、昇華、蒸発などによる記録、Te-Ge系、As-Te-Ge系、Te-O系などの相転移(相変化ともいう)、フォトダークニングなど原子配列変化による記録などが知られている。

【0004】一方、予め情報が記録されており、放射線による情報の記録、消去を行わない再生専用の光情報記録媒体が、オーディオ部門や映像部門などで広く普及している。CD (コンパクトディスク) はオーディオ部門で普及している再生専用の光情報記録媒体の代表的なものであり、ビデオディスクは映像部門で普及している再生専用の光情報記録媒体の代表的なものである。これら再生専用の光情報記録媒体における再生信号の仕様は、例えばCDフォーマットとして規格化されている。

【0005】さらには、情報の追記が可能でCDプレーヤで情報の再生が可能な光情報記録媒体(追記型CD)や、同じく情報の追記が可能でビデオディスクブレーヤで情報の再生が可能な光情報記録媒体(追記型ビデオディスク)の開発が盛んに行われている。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】上記追記型CDや追記型ビデオディスクを実用化するためには、反射率や記録した情報の信号変調度などを、各プレーヤが要求する条件を満たすようにする必要がある。例えば追記型CDについていえば、反射率が70%以上、11T信号記録時の信号変調度が60%以上などの条件を満たさなくてはならない。

が形成された光情報記録媒体に記録用放射線ビームを照 射し、その熱によって上記記録層の記録用放射線ビーム 照射部を溶融して混合させ、かつ該部下地の基板又は熱 変形層を変形させて情報の記録を行い、また、上記記録 50 ように設定されているために、CDプレーヤやビデオデ ィスクプレーヤでの情報の再生が不可能である。また、 光情報記録媒体を従来のCDと同様に単板構造に形成す ると、特に耐環境性に優れることが要求されるが、従来 の追記型の記録材料はいずれも耐環境性に難点があり、 この点からも追記型CDとして用いることは不適であ る。

【0008】本発明は、上記した従来技術の現状に鑑みてなされたものであって、記録特性が良く、CDプレーヤもしくはビデオディスクプレーヤでの再生が可能で、かつ耐環境性に優れた光情報記録媒体、および当該光情 10報記録媒体に対する情報の記録再生方法を提供することを目的とする。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の目的を達成するため、基板の信号面に、少なくとも記録層を含む薄膜を担持してなる光情報記録媒体において、上記基板の信号面に、直接または耐熱性が上記基板より低い物質からなる熱変形層を介して、〔Ge, Si, Sn〕元素群から選択された少なくとも1種類の元素と、〔Au, Ag, A1, Cu〕元素群から選択された少なくと 20も1種類の元素とを主成分とする合金からなる記録層を形成した。

【0010】また、他の手段として、上記と同様の光情報記録媒体において、上記基板の信号面に、直接または上記基板よりも耐熱性の低い物質からなる熱変形層を介して、〔Ge, Si, Sn〕元素群から選択された少なくとも1種類の元素を主成分とする薄膜と、〔Au, Ag, A1, Cu〕元素群から選択された少なくとも1種類の元素を主成分とする薄膜とを2枚以上重ねた積層体からなる記録層を形成した。

【0011】なお、基板が比較的耐熱性の低いプラスチック材料によって形成される場合には、上記記録層は基板の信号面に直接形成され、基板がガラスなどのセラミック材料や比較的耐熱性の高いプラスチック材料によって形成される場合には、上記記録層は基板の信号面に形成された熱変形層上に積層される。

【0012】また、多重干渉効果によって高い反射率を得るため、基板側から見て記録層の背面側に、当該記録層よりも再生用光に対する反射率が高い反射層を積層することもできる。この反射率の高い反射層材料として 40は、Au、Alなども有効である。

【0013】さらには、より高い多重干渉効果を得ると ともに、熱の拡散を防いで記録感度を高めるため、基板 側から見て記録層の背面側に、無機材料からなる中間層 と、上記記録層よりも再生用光に対する反射率が高い反 射層とを順次積層することもできる。

【0014】情報の記録再生方法については、基板の信号面に、直接または上記基板よりも耐熱性の低い物質からなる熱変形層を介して、〔Ge、Si、Sn〕元素群から選択された少なくとも1種類の元素と、〔Au、A 50

g, A1, Cu) 元素群から選択された少なくとも1種類の元素とを主成分とする合金からなる記録層が形成された光情報記録媒体に、記録用放射線ビームを照射し、その熱によって上記記録層の記録用放射線ビーム照射部の原子配列を変化させ、かつ該部下地の基板または熱変形層を変形させて情報の記録を行い、また、上記記録層の原子配列の変化および上記基板または熱変形層の変形に伴う反射率の変化を光学的に読み出すことによって情報の再生を行うといった方式をとる。

4

【0015】また、他の手段として、基板の信号面に、直接または上記基板よりも耐熱性の低い物質からなる熱変形層を介して、〔Ge、Si、Sn〕元素群から選択された少なくとも1種類の元素を主成分とする薄膜といくとも1種類の元素を主成分とする薄膜とからなる2層以上の積層体からなる記録層が形成された光情報記録媒体に、信号変調された記録層が形成された光情報記録媒体に、信号変調された記録層が形成された光情報記録媒体に、信号変調された記録層が形成された光情報記録媒体に、信号変調された記録層が形成された光情報記録媒体に、信号変調された記録層が形成された光情報記録を密設して混合させ、かつ該部下地の基板または熱変形層を変形させて情報の記録を行い、また、上記記録層の混合部および上記基板または熱変形層の変形に伴う反射率の変化を光学的に読み出すことによって情報の再生を行うといった方式をとる。

#### [0016]

【作用】 [Ge, Si, Sn] 元素群から選択された少なくとも1種類の元素(以下、これをA群元素という)と [Au, Ag, Al, Cu] 元素群から選択された少なくとも1種類の元素(以下、これをB群元素という)とが適当な比率で存在する合金は、70%以上の反射率を持つ。また、この合金は共晶組織を持ち、融点が比較的低いので、記録感度が良好であるばかりでなく、原子配列変化、例えば非晶質相から結晶質相への変化などを高速で行うことができる。さらには、この合金は、耐環境性特に耐食性に優れる。よって、追記型CDもしくは追記型ビデオディスクに好適な記録層となり得る。

【0017】一方、上記A群元素を主成分とする薄膜と B群元素を主成分とする薄膜を積層しても、70%以上 の反射率と、高い耐環境性を持たせることができる。ま た、記録時の光熱によって上記両方の薄膜を溶融して合 金化すると、各薄膜が単独で存在する場合に比べて反射 率が変化する。よって、追記型CDもしくは追記型ビデ オディスクに好適な記録層となり得る。

【0018】また、記録用放射線ピームを照射することによって記録層の原子配列を変化させ、かつ該部下地の基板または熱変形層を変形させて情報の記録を行い、また、上配原子配列の変化および上記基板または熱変形層の変形に伴う反射率の変化を光学的に読み出すことによって情報の再生を行うと、記録層の原子配列のみを変化させることによって情報を記録する場合に比べて、記録部の反射率変化を格段に大きくすることができるので、

良好な再生特性を得ることができる。

【0019】記録用放射線ピームを照射することによっ てA群元素を主成分とする薄膜とB群元素を主成分とす る薄膜を溶融して混合させ、かつ該部下地の基板または 熱変形層を変形させて情報の記録を行い、また、上記記 録層の混合および上記基板または熱変形層の変形に伴う 反射率の変化を光学的に読み出すことによって情報の再 生を行う場合も同様である。

[0020]

って説明する。第1図は本例に係る光情報記録媒体の要 部断面図、第2図は平面図、第3図は本例の光情報記録 媒体を用いた情報の記録再生方法を示す説明図である。

【0021】第1図に示すように、本例の光情報記録媒 体は、基板1の信号面2に、基板1側より、記録層3と 保護層4とを順次積層してなる。

【0022】基板1は、例えばポリカーボネート、ポリ オレフィン、エポキシ、アクリルなど、比較的熱変形し やすい透明なプラスチック材料をもって、所望の形状お よび寸法に形成される。

【0023】信号面2には、光ビームスポットを案内す るための案内溝やヘッダー信号を表すプリピット列など の信号パターン5が微細な凹凸状に形成される。上記信 号パターン5は、第2図に示すように、基板1と同心の 渦巻状もしくは同心円状に形成される。

【0024】記録層3は、 (Ge. Si, Sn) 元素群 から選択された少なくとも1種類の元素(A群元素) と、〔Au、Ag、Al、Cu〕元素群から選択された 少なくとも1種類の元素(B群元素)とを主成分とする 合金にて形成される。

【0025】もちろん、添加元素として、例えばT1、 Co. Fe. Ni, Sc. Ti. V. Cr. Mn. Z n, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Cd. Hf, Ta. W. Re, Os, Ir. Pt, Te, S e, Sb, S, Hg, As, B, C, N, P, O, AD ゲン元素、アルカリ金属元素、アルカリ土類金属元素、 アクチニド元素、ランタニド元素、不活性ガス元素など のうちの少なくとも1元素を含んでも良い。

【0026】上記各元素のうち、Co, Ni, Sc, T i. V. Cr. Mn. Zn. Y, Zr. Nb. Mo, R 40 u, Rh, Pd, Cd, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir、Pt、Feは、半導体レーザ光などの長波長光の 吸収を容易にして記録感度を高める効果を持ち、また高 速結晶化を可能にする。Te、Se、Sb、Sは、非晶 質状態の安定性を増し、かつ耐酸化性を向上させる効果 を持つ。TI、ハロゲン元素、アルカリ金属元素は、結 晶化速度を向上させ、かつ非晶質状態の安定性を増す効 果を持つ。N、O、Arは、非晶質状態の安定性を増す 効果を持つ。また、希土類元素などは、結晶化温度を高 めるなどの役割を果させ得る。

【0027】上記記録材料のうちでは、〔GeまたはS n〕のうちの少なくともいずれか一方の元素とA1とを 主成分とする合金であって、その膜厚方向の平均組成が 下記の一般式にて表されるものが特に好ましい。

[0028] AlxMAaMBbMCcMDd ただし、MAは〔GeまたはSn〕のうちの少なくとも いずれか一方の元素、MBは〔Te、Se、S〕元素群 から選択された少なくともいずれか一つの元素、MCは (B, C, P) 元素群から選択された少なくともいずれ 【実施例】本発明の第1実施例を、第1図〜第3図によ 10 かーつの元素、MDは上記A1(アルミニウム)および MA、MB、MCで表される元素以外の元素である。上 記MDで表される元素としては、例えばTl, Au, A g, Cu, Pd, Ta, W, Ir, Sc, Y, Ti, Z r, V, Nb, Cr, Mo, Mn, Fe, Ru, Co, Rh, Ni, Sb, Si, Hg, As, N, O, ハロゲ ン元素、アルカリ金属元素、アルカリ土類金属元素、ア クチニド元素、ランタニド元素、不活性ガス元素などの

> 【0029】上記の一般式における添字 x, a, b, 20 c. dは各成分の含有率を示し、下記の範囲に設定する ことができる。ただし、単位は原子%である。

 $[0030]10 \le x \le 95$ 

各元素を挙げることができる。

5 ≤ a ≤ 9 0

0 ≤ b ≤ 3 0

 $0 \le c \le 30$ 

 $0 \le d \le 30$ 

なお、各成分の含有率を下記の範囲に設定すると、より 好ましい結果を得ることができる。

 $[0031]20 \le x \le 93$ 

30 7≤a≤80

0 ≤ b ≤ 2 0

 $0 \le c \le 20$ 

 $0 \le d \le 20$ 

さらに、各成分の含有率を下記の範囲に設定すると、特 に好ましい結果を得ることができる。

 $[0032]30 \le x \le 90$ 

10≤a≤70

 $0 \le b \le 15$ 

 $0 \le c \le 15$ 

 $0 \le d \le 15$ 

上記の各組成において、MAで表される元素がGeであ る場合には、耐食性の面から

 $1 \leq b + c + d \leq 20$ 

とすることが特に好ましい。

【0033】また、記録層3内における各成分の分布 は、均一であっても良いし、膜厚方向に濃度勾配を有し ていても良い。例えば、Se, Sb, Sについては、記 録層3の表層部により多く分布させた方が好ましい。

【0034】保護層4は、例えばAlN、Al2O3、S iN,SiO₂などの無機材料、または光硬化性樹脂な 50

8

どの有機材料をもって形成される。

【0035】以下、第3図により、上記第1実施例の光 情報記録媒体を用いた情報の記録再生方法について説明 する。

【0036】第3図に示すように、CDフォーマットな どの所定の方式で信号変調された記録用放射線ビーム6 を上記記録層3に合焦すると、その光エネルギーが上記 記録層3によって熱エネルギーに変換され、その熱によ って上記記録層3の記録用放射線ビーム照射部7の原子 配列を変化されるとともに、該部下地の基板1が熱変形 10 8されて情報の記録が行われる。したがって、上記原子 配列の変化および上記基板1の熱変形に伴う反射率の変 化を光学的に読み出すことによって情報の再生を行うこ とができる。なお、情報の記録は、案内溝上に行うこと もできるし、相隣接する案内溝の間の平坦部に行うこと もできる。ただし、畜熱効果が顕著で、記録層3の原子 配列を速やかに変化させ、かつ基板1に大きな熱変形を 生じさせることができるため、溝上に記録する方がより 記録再生特性を高める上で有利である。

【0037】かように、上記第1実施例の光情報記録媒 20 体は、記録層3の原子配列を変化させるのみならず、基 板1を熱変形させることによって情報を記録するので、 大きな信号変調度を得ることができる。

【0038】次に、本発明の第2実施例を、第4図およ び第5図によって説明する。第4図は本例に係る光情報 記録媒体の要部断面図であり、第5図は記録再生原理を 示す説明図である。

【0039】第4図に示すように、本例の光情報記録媒 体は、記録層3が、A群元素を主成分とする第1の薄膜 成されている。その他については、上記第1実施例と同 じであり、重複を避けるため、説明を省略する。

【0040】第5図により、上記第2実施例の光情報記 録媒体を用いた情報の記録再生方法について説明する。

第5図に示すように、CDフォーマットなどの所定の 方式で信号変調された記録用放射線ビーム6を上記記録 層3に合焦すると、その光エネルギーが上記記録層3に よって熱エネルギーに変換され、その熱によって上記記 録層3を構成する第1の薄膜3aおよび第2の薄膜3b が融解し、互いに混合しあう。また、その熱によって、 記録用放射線ビーム照射部7の下地の基板1が熱変形8 されて情報の記録が行われる。したがって、薄膜3a. 3 bの混合、それに上記基板1の熱変形に伴う反射率の 変化を光学的に読み出すことによって情報の再生を行う ことができる。

【0041】第2実施例の光情報記録媒体も、上記第1 実施例の光情報記録媒体と同様の効果がある。

【0042】次に、本発明の第3実施例を、第6図によ って説明する。第6図は本例に係る光情報記録媒体の要 部断面図である。

【0043】第6図に示すように、本例の光情報記録媒 体は、基板1と記録層3との間に、基板1よりも耐熱性 の低い物質からなる熱変形層11が設けられている。本 例の光情報記録媒体は、基板材料として、ガラスや熱硬 化性樹脂などの耐熱性が高い材料を用いた場合に特に効 果がある。熱変形層11を形成する物質としては、熱可 塑性樹脂が特に好適である。

【0044】なお、第6図においては、記録層3が単層 にて表されているが、第2実施例の光情報記録媒体のよ うに、複数の薄膜の積層体から記録層3を形成すること もできる。その他については、上記第1、第2実施例と 同じであり、重複を避けるため、説明を省略する。

【0045】第3実施例の光情報記録媒 体も、上記第 1、第2実施例の光情報記録媒体と同様の効果がある。

【0046】次に、本発明の第4実施例を、第7図によ って説明する。第7図は本例に係る光情報記録媒体の要 部断面図である。

【0047】第7図に示すように、本例の光情報記録媒 体は、基板 1 側から見て記録層 3 の背面側に、光吸収層 12が設けられている。

【0048】なお、第7図においては、記録層3が単層 にて表されているが、第2実施例の光情報記録媒体のよ うに、複数の薄膜の積層体から記録層3を形成すること もできる。その他については、上記第1、第2実施例と 同じであり、重複を避けるため、説明を省略する。

【0049】第4実施例の光情報記録媒体は、記録層3 の背面側に光吸収層12を設けたので、発熱量が大き く、記録感度をより向上させる効果がある。

【0050】次に、本発明の第5実施例を、第8図によ 3aとB群元素を主成分とする第2の薄膜3bとから構 30 って説明する。第8図は本例に係る光情報記録媒体の要 部断面図である。

> 【0051】第8図に示すように、本例の光情報記録媒 体は、基板1側から見て記録層3の背面側に、反射層1 3が設けられている。反射層13を形成する物質として は、Au、Ag、Alなどの金属材料が特に好適であ る.

> 【0052】なお、第8図においては、記録層3が単層 にて表されているが、第2実施例の光情報記録媒体のよ うに、複数の薄膜の積層体から記録層3を形成すること もできる。その他については、上記第1、第2実施例と 同じであり、重複を避けるため、説明を省略する。

【0053】第5実施例の光情報記録媒体は、記録層3 の背面側に反射層13を設けたので、記録層3と反射層 13との間で多重干渉効果を生じ、より高い反射率を得 ることができる。

【0054】次に、本発明の第6実施例を、第9図によ って説明する。第9図は本例に係る光情報記録媒体の要 部断面図である。

【0055】第9図に示すように、本例の光情報記録媒 50 体は、基板1側から見て記録層3の背面側に、中間層1

4と反射層12とが順次積層されている。

【0056】中間層14の例を挙げると、Ce, La, Si, In, Al, Ge, Pb, Sn, Bi, Te, T a, Sc, Y, Ti, Zr, V, Nb, Cr, Wよりな る群より選ばれた少なくとも1元素の酸化物、Cd. 2 n, Ga, In, Sb, Ge, Sn, Pb, Biよりな る群より選ばれた少なくとも1元素の硫化物またはセレ ン化物、Mg, Ce, Caなどの弗化物、Si, Al, Ta、Bなどの窒化物、B、Siなどの炭化物、Tiな どのホウ化物、ホウ素、炭素よりなるものであって、例 10 えば主成分がCeO₂,La₂O₃.SiO,SiO₂, I n:O3, Al2O3, GeO, GeO2, PbO, Sn O, SnO2, Bi2O3, TeO2, Ta2O5, Sc 2 O3, Y2 O3, TiO2, ZrO2, V2 O5, Nb2 O5, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, WO<sub>2</sub>, WO<sub>3</sub>, CdS, ZnS, CdSe, ZnSe, In2S2, In2Se3, Sb2S1, Sb2S es, GarSs, GarSes, GeS, GeSe, Ge Se2, SnS. SnS2, SnSe, SnSe2, Pb S, PbSe, Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>, Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, MgF<sub>2</sub>, Ce i, TiB2, B4C, SiC, B, Cのうちの一者に近 い組成を持ったもの、およびこれらの混合物である。

【0057】これらのうち、硫化物では、ZnSに近い ものが、屈折率が適当な大きさで膜が安定である点で好 ましい。窒化物では、表面反射率があまり高くなく、膜 が安定かつ強固である点で、TaN, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, A1N (窒化アルミニウム)、またはAISiN₂に近い組成 のものが好ましい。酸化物では、Y2O1、Sc2O3、C eO2, TiO2, ZrO2, SiO, Ta2O5, In 好ましい。Siの水素を含む非晶質も好ましい。

【0058】反射層12を形成する物質としては、上記 第5実施例と同様に、Au、Ag、A1などの金属材料 が用いられる。

【0059】なお、第9図においては、記録層3が単層 にて表されているが、第2実施例の光情報記録媒体のよ うに、複数の薄膜の積層体から記録層3を形成すること もできる。その他については、上記第1、第2実施例と 同じであり、重複を避けるため、説明を省略する。

の背面側に中間層14および反射層12を設けたので、 多重干渉効果がより高められ、より高い反射率を得るこ とができる。また、記録層3で発生した熱が反射層12 に拡散するの中間層14にて抑制することができ、より 高い記録感度を得ることができる。

【0061】なお、上記第1実施例の光情報記録媒体に おいては、主として記録層3が光熱の作用によって非晶 質相と結晶質相との間の変化を利用して情報の記録が行 われるものと思われるが、必ずしも非晶質状態と結晶状 原子配列変化によって光学的性質の変化を起させれば良 い。例えば、結晶粒径や結晶形の変化などでも良い。非 晶質状態と結晶状態の変化でも、非晶質は完全な非晶質 でなく、結晶部分が混在していても良い。また、記録層 を多層構造とした場合、各層を形成する原子のうちの一 部が移動(拡散、化学反応などによる)することによ り、あるいは移動と相変化の両方により記録されても良 610

【0062】以下に、より具体的な実験例を示し、本発 明の効果を明らかにする。

【0063】 (実験例1) 直径12cm、厚さ1.2m mのポリカーポネート基板 を、複数のターゲットを持 ち、膜厚の均一性および再現性の良いマグネトロンスパ ッタリング装置に入れ、基板上に記録層である厚さが約 80 nmのAuzoGezoの組成の薄膜を形成し、次いで この薄膜上に紫外線硬化樹脂による保護層を100μm の厚さにスピンコートした。

【0064】上記のように作成したディスクを用いて、 下記の条件で情報の記録・再生を行った。まず、ディス F<sub>3</sub>, CaF<sub>2</sub>, TaN, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, AlN, BN, S 20 クの線速を1.2m/sとし、半導体レーザ (波長78 0 nm) の光を記録が行われないレベル (約1mW) に 保った。この光を記録ヘッド中のレンズで集光して基板 を通して記録層に照射し、反射光を検出することによっ て、トラッキング用の案内溝上に光スポットの中心が一 致するように記録ヘッドを駆動した。このようにしてト ラッキングを行いながら、さらに記録層上に焦点が来る ように自動焦点合わせを行い、レーザ光を照射してピッ トを形成した。続いて、記録時と同じようにトラッキン グと自動焦点合わせを行いながら、記録が行われた低バ  ${}_2\,{\sf O}_3$ , ${\sf A}\,\,{\sf I}_{\,2}\,{\sf O}_3$ , ${\sf S}\,\,{\sf n}\,\,{\sf O}_2$ , ${\sf S}\,\,{\sf i}\,\,{\sf O}_2$ に近い組成のものが 30 ワーの半導体レーザ光で反射光の強弱を検出し情報を再 生した。

> 【0065】本実験例では、再生光パワーを1mWとし たときに、約1.3Vの信号強度が得られた。これは市 販のCDとほぼ同じレベルである。また、記録パワーを 7mWとし、周波数196KHzの信号(11T信号) を記録したときに、約70%の信号変調度が得られた。

【0066】ディスクから上記の方法で記録を行ったト ラックを含む小片を切り出し、これをテトラヒドロフラ ンに浸してポリカーポネートを溶かし、記録層のみを取 【0060】第6実施例の光情報記録媒体は、記録層3 40 り出した。これを透過電子顕微鏡により観察した結果、 未記録部分は結晶状態、記録部分は非晶質状態であっ た。また、記録済みのトラックを含む小片から記録層の みを除去して走査電子顕微鏡により観察した。その結 果、記録部分の基板の変形を確認した。このように、記 録層の原子配列変化および基板変形の両方を起すことに よって記録を行い、大きな信号変調度を得ることは、本 発明の特徴の1つである。

【0067】案内溝上に行ったのと同様の方法で相隣接 する溝間に記録を行ったところ、良く似た特性が得られ 態との間の変化を記録に利用する必要はなく、何らかの 50 た。ただし、信号変調度は、溝上記録に比べて少し小さ

10

くなった。

【0068】本実験例の媒体は、耐環境性にも優れており、気温80℃相対湿度90%の環境下に1000時間置いた後でも、反射率および透過率はほとんど変化しなかった。

【0069】なお、Auの一部または全部を置換してAg, Cu. <math>Aloうちの少なくとも1元素を添加しても、良く似た特性が得られた。また、Geの一部または全部を置換して<math>SiおよびSnのうちの少なくとも1元素を添加しても、良く似た特性が得られた。

【0070】また、上記の光情報記録媒体において、基 板側から見て記録層の背面側に反射層を設けると、再生 出力信号が向上した。また、記録層と上記反射層との間 に中間層を設けると、記録感度が向上した。中間層とし ては、CeO<sub>2</sub>、La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、SiO、SiO<sub>2</sub>、In 2O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, GeO, GeO<sub>2</sub>, PbO, SnO, SnO2, Bi2O3, TeO2, Ta2O5, Sc2O3, Y 2 O 3, T i O 2, Z r O 2, V 2 O 5, N b 2 O 5, C r 2O3, WO2, WO3, CdS, ZnS, CdSe, Zn Se, In<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>, Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, Sb<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>, Ga2S3, Ga2Se3, GeS, GeSe, GeS e2, SnS, SnS2, SnSe, SnSe2, Pb S, PbSe, Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>, Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, MgF<sub>2</sub>, Ce F3. CaF2, TaN, Si3N4, AlN, BN, S i, TiB<sub>2</sub>, B<sub>4</sub>C, SiC, B, Cのうちの一者に近 い組成を持ったもの、およびこれらの混合物を用いたと きに、特に効果があった。

【0071】さらに、基板として、ポリカーボネートの代りに、表面に直接案内溝などの信号パターンが形成されたポリオレフィン、エボキシ、アクリル樹脂を用いた 30場合にも、上記とほぼ同様の結果が得られた。

【0072】〈実験例2〉上記実験例1と同様のポリカーボネート基板を多数用意し、各基板ごとに上記実験例1と同様の方法で、Sn含有率が異なるAl-Sn系記録層を形成し、記録層中のSn含有率が異なる各種のディスクを作製した。ただし、各ディスクとも記録層の厚さは約60nmであり、記録層上には、紫外線硬化樹脂製の保護層を100μmの厚さにスピンコートした。

【0073】下記に、記録層中のSn含有率を種々変更 したときの、再生出力信号強度の変化と、記録に必要な 40 レーザパワーの変化とを示す。記録・再生条件および記録・再生方法は、上記実験例1にて説明したと同じである。

[0074]

(原子%)	再生出力信号 強度(Yolt)	パワー(元間)
3	1.60	記録できず
5	1.55	1 2
7	1.50	10
10	1.40	8
70	1.20	6
8 0	1. 15	6
9 0	1.10	6
9 5	1.00	6

12

また、上記実験例1と同様のポリカーボネート基板を多数用意し、各基板ごとに上記実験例1と同様の方法で、AlとSnとの相対的比率を70:20と一定にし、B含有率が異なるAl-Sn-B系記録層を形成し、記録層中のB含有率が異なる各種のディスクを作製した。ただし、各ディスクとも記録層の厚さは約60nmであり、記録層上には、紫外線硬化樹脂製の保護層を100μmの厚さにスピンコートした。

【0075】下記表に、記録層中のB含有率を種々変更 20 したときの、再生出力信号強度の変化と、ノイズレベル の変化とを示す。記録・再生条件および記録・再生方法 は、上記実験例1にて説明したと同じである。

[0076]

B含有率	再生出力信号	ノイズレベル (dBm)	
(原子%)	強度(Volt)		
0	1.35	<b>-60</b>	
1	1.35	<b>-62</b>	
15	1.20	<b>-6</b> 5	
20	1.15	<b>-6</b> 5	
30	1. 10	<del>-</del> 65	
3 5	1.00	<b>-65</b>	

なお、Snの一部または全部を置換してGeを添加しても、良く似た特性が得られた。また、Bの一部または全部を置換してCおよびPのうちの少なくとも1元素を添加しても、良く似た特性が得られた。また、上記MDで表される元素を添加すると、記録感度が若干向上した

【0077】その他については、上記実験例1と同様の結果が得られた。

【0.078】なお、上記各実施例においては、基板1のほぼ全域にわたって信号パターン5を形成し、情報の追記ができるようにしたが、第10図に示すように、基板1の記録領域をROM領域21と追記領域22とに分け、ROM領域21にはROM情報をCDフォーマットに適合したプリピットの形で記録し、追記領域22には上記の信号パターンを形成して情報の追記ができるようにすることもできる。

【0079】また、上記各実施例においては、いわゆる 追記型CDを例にとって説明したが、ビデオディスク信 50 号を記録可能で、ビデオディスクプレーヤで再生可能な ディスクにも応用することができる。

#### [0080]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の光情報記 録媒体は、A群元素とB群元素とを主成分とする合金か らなる記録層、またはA群元素を主成分とする薄膜とB 群元素を主成分とする薄膜との積層体からなる記録層を 形成したので、反射率が高く、かつ信号変調度が大き く、さらには耐酸化性に優れている。よって、情報の追 記が可能にして、CDプレーヤやレーザディスクプレー ヤで情報の再生を行うことができ、かつ耐環境性に優れ 10 た光情報記録媒体を提供することができる。

【0081】また、本発明の情報の記録再生方法は、記 録層に原子配列変化を生じさせるとともに、基板に熱変 形を生じさせるようにしたので、記録部と非記録部の反 射率の差が大きく、大きな再生出力信号を得ることがで きる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施例に係る光情報記録媒体の要部断面図

【図2】第1実施例に係る光情報記録媒体の平面図であ 20 4 保護層 る。

【図3】第1実施例に係る光情報記録媒体の記録再生原 理の説明図である。

【図4】第2実施例に係る光情報記録媒体の要部断面図

である。

【図5】第2実施例に係る光情報記録媒体の記録再生原 理の説明図である。

【図6】第3実施例に係る光情報記録媒体の要部断面図 である。

【図7】第4実施例に係る光情報記録媒体の要部断面図 である。

【図8】第5実施例に係る光情報記録媒体の要部断面図 である。

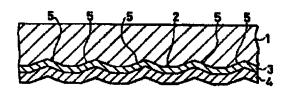
【図9】第6実施例に係る光情報記録媒体の要部断面図 である。

【図10】他の実施例に係る光情報記録媒体の平面図で ある。

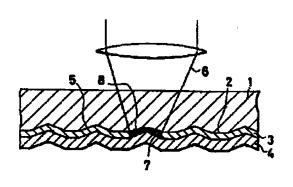
#### 【符号の説明】

- 1 基板
- 2 信号面
- 3 記録層
- 3 a 第1の薄膜
- 3 b 第2の薄膜
- - 11 熱変形層
  - 12 光吸収層
  - 13 反射層
  - 14 中間層

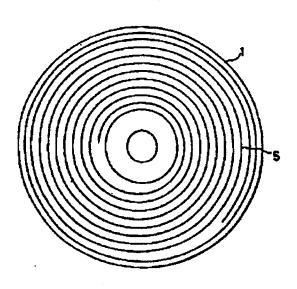
【図1】



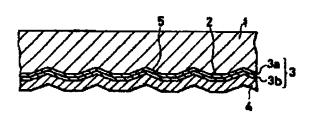
[図3]

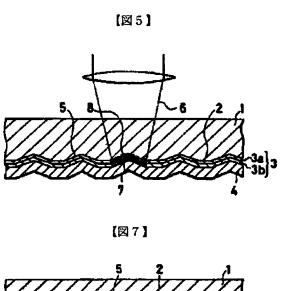


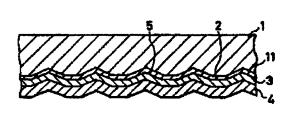
【図2】



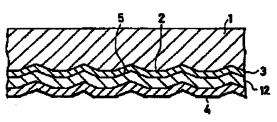
【図4】







[図6]



【図9】

